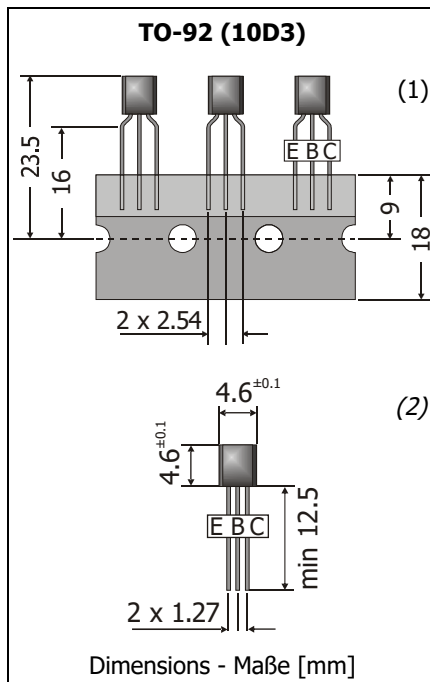


MPSA56
General Purpose PNP Transistors
Universal-PNP-Transistoren

$I_C = -500 \text{ mA}$ $V_{CE0} = -80 \text{ V}$
 $h_{FE} > 100$ $P_{tot} = 625 \text{ mW}$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

Version 2018-01-19

**Typical Applications**

Signal processing,
 Switching, Amplification
 Commercial grade ¹⁾

Features

General purpose
 Two raster versions
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

**Mechanical Data ¹⁾**

(1) Taped in ammo pack 4000
 (Raster 2.54)
 (2) *On request: in bulk* 5000
 (Raster 1.27, suffix "BK")
 Weight approx. 0.18 g
 Case material UL 94V-0
 Solder & assembly conditions 260°C/10s
 MSL N/A

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
 Schalten, Verstärken
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Universell anwendbar
 Zwei Raster-Versionen
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

(1) Gegurtet in Ammo-Pack
 (Raster 2.54)
 (2) *Auf Anfrage: Schüttgut*
 (Raster 1.27, Suffix "BK")
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

Recommended complementary NPN transistors
Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren

MPSA06

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

			MPSA56
Collector-Emitter-voltage Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V_{CE0}	80 V
Collector-Base-voltage Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V_{CBO}	80 V
Emitter-Base-voltage Emitter-Basis-Spannung	C open	- V_{EBO}	4 V
Power dissipation Verlustleistung		P_{tot}	625 mW ³⁾
Collector current Kollektorstrom	DC	- I_C	500 mA
Peak Collector current Kollektor-Spitzenstrom		- I_{CM}	1 A
Peak Base current Basis-Spitzenstrom		- I_{BM}	200 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-55...+150°C -55...+150°C

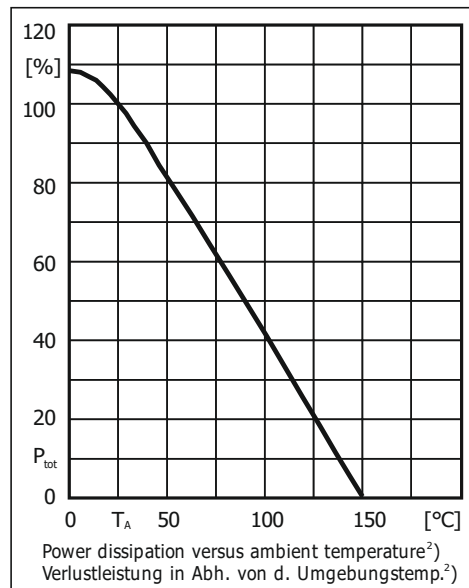
1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben

3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
 Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

	$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾ - $V_{CE} = 1\text{ V}$ - $I_C = 10\text{ mA}$ - $I_C = 100\text{ mA}$	h_{FE}	100 100	–	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ¹⁾ - $I_C = 100\text{ mA}$ - $I_B = 10\text{ mA}$	- V_{CEsat}	–	–	0.25 V
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾ - $I_C = 100\text{ mA}$ - $V_{CE} = 1\text{ V}$	- V_{BE}	–	–	1.2 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom - $V_{CB} = 80\text{ V}$ E open	- I_{CBO}	–	–	100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom - $V_{EB} = 4\text{ V}$ C open	- I_{EBO}	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz - $I_C = 100\text{ mA}$, - $V_{CE} = 1\text{ V}$, $f = 100\text{ MHz}$	f_T	50 MHz	–	–
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung	R_{thA}	< 200 K/W ²⁾		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
 Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden